

## 高频低噪声 NPN 晶体管

### 描述:

硅外延 NPN 晶体管

### 应用:

高频低噪声放大, 用于 VHF, UHF 和 CATV

### 工作条件(T=25℃):

参数	符合	极值	单位
BC 击穿电压	$V_{CBO}$	20	V
EC 击穿电压	$V_{CEO}$	12	V
EB 击穿电压	$V_{EBO}$	3	V
集电极电流	$I_C$	200	mA
功耗	$P_C$	0.5	W
结温度	$T_j$	150	℃
存储温度	$T_{stg}$	-65-+150	℃

### 电学特性 (T=25℃)

参数	符合	最小	典型	最大	单位	测试条件
BC 击穿电压	$BV_{CBO}$	20			V	$I_C=10\mu A$
EC 击穿电压	$BV_{CEO}$	12			V	$I_C=1mA$
EB 击穿电压	$BV_{EBO}$	3			V	$I_E=10\mu A$
集电极关断电流	$I_{CBO}$			1	$\mu A$	$V_{CB}=10V$
发射极关断电流	$I_{EBO}$			1	$\mu A$	$V_{EB}=1V$
直流增益	$h_{FE}$	50	120	300		$V_{CE}=10V, I_C=20mA$
频率	$f_T$		5		GHz	$V_{CE}=10V, I_C=20mA$
输出电容	$C_{ob}$		0.65	1.0	pF	$V_{CB}=10V, I_E=0A, f=1MHz$
功率增益	$ S_{21c} ^2$		9.5		db	$V_{CE}=10V, I_E=20mA, f=1GHz$
噪声因子	NF		1.1		db	$V_{CE}=10V, I_C=7mA, f=1GHz$
噪声因子	NF		1.8	3.0	db	$V_{CE}=10V, I_C=40mA, f=1GMHz$

封装形式:

TO-92

